

Silicon Diode

S587

20V / 100mA

DATASHEET

OEM – SEL

Source: SEL Databook 1965



Silizium-Planar-Diode **S 587**

Ausführung

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode im Miniatur-Glasgehäuse. Kathode durch Farbpunkt gekennzeichnet.

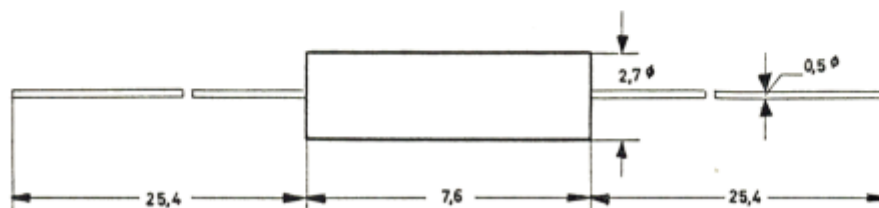
Verwendung

Diode für allgemeine Anwendungen in der kommerziellen Technik.

Abmessungen

(Maße in mm)

Gehäuse DO-7



Grenzdaten

Verlustleistung	$T_u = 25\text{ °C}$	P	250	mW
Sperrspannung	$T_u = 25\text{ °C}$	U_R	20	V
Durchlaßgleichstrom		I_F	100	mA
Maximale Sperrschichttemperatur		$+T_j$	150	°C
Minimale Gehäusetemperatur		$-T_G$	55	°C
Maximale Lagertemperatur		$+T_s$	150	°C
Minimale Lagertemperatur		$-T_s$	55	°C

S 587**Statische Kenndaten bei $T_U = 25\text{ °C}$**

Sperrstrom	$U_R = 20\text{ V}$	I_R	< 1	μA
Durchlaßstrom	$U_F = 0,85\text{ V}$	I_F	> 10	mA
Wärmewiderstand		R_{thU}	0,5	$^{\circ}\text{C}/\text{mW}$

